

GAP-SETTING DEVICE

PUB. NO.: 63-243804 [JP 63243804 A]

PUBLISHED: October 11, 1988 19881011)*

INVENTOR(s): ISHIBASHI YORIYUKI

HIRANO RYOICHI

SHIMOZONO HIROAKI

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

TOKYO OPTICAL CO LTD [330193] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 62-078701 [JP 8778701]

FILED: March 31, 1987 (19870331)

INTL CLASS: [4] G01B-011/14; G03F-007/207; H01L-021/30; H01L-021/68

JAPIO CLASS: 46.1 (INSTRUMENTATION -- Measurement); 29.1 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Photography & Cinematography); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD: R002 (LASERS); R129 (ELECTRONIC MATERIALS -- Super High Density Integrated Circuits, LSI & GS

JOURNAL: Section: P, Section No. 823, Vol. 13, No. 50, Pg. 61,

February 06, 1989 (19890206)

ABSTRACT

PURPOSE: To suppress a ripple component at the zero-cross point of a detection signal and to improve the setting accuracy of a gap by providing 1st and 2nd bodies with 1st and 2nd diffraction* gratings and setting the longitudinal and lateral* pitches of the 2nd diffraction* gratings equal to each other.

CONSTITUTION: A mask 13 and a wafer* 12 are provided with diffraction gratings 31a and 31b, and 32a and 32b, and laser light C from a laser light source 17 is diffracted through the operation of the double diffraction grating while transmitted through the gratings 31a and 31b, reflected by the gratings 32a and 32b, and then transmitted through the gratings 31a and 31b again. Those diffracted light beams are inputted to a signal processing circuit 20 through mirrors 19a and 19b and the gap between the mask 13 and wafer* 12 is adjusted 21. At this time, the longitudinal and lateral* pitches of the diffraction* gratings 32a and 32b are set equal to each other. Consequently, the ripple component at the zero-cross point is suppressed and the proper gap is set.

1/5/15 (Item 11 from file: 347)

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01390227 **Image available**

DETECTING OPTICAL SYSTEM

PUB. NO.: 59-101827 [JP 59101827 A]

PUBLISHED: June 12, 1984 19840612)*

⑫ 公開特許公報 (A)

昭63-248804

⑤Int.Cl.¹C 08 F 10/00
4/64

識別記号

M F G
1 0 1

庁内整理番号

8319-4J
8319-4J

⑬公開 昭和63年(1988)10月17日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全12頁)

⑭発明の名称 オレフィン重合用触媒

⑯特願 昭62-82425

⑯出願 昭62(1987)4月3日

⑭発明者 松浦 満幸 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社樹脂研究所内

⑭発明者 藤田 孝 三重県四日市市東邦町1番地 三菱油化株式会社樹脂研究所内

⑯出願人 三菱油化株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

⑯代理人 弁理士 佐藤 一雄 外2名

明細書

成分 (B)

有機アルミニウム化合物。

1. 発明の名称

オレフィン重合用触媒

3. 発明の詳細な説明

【発明の背景】

技術分野

本発明は、オレフィン重合用触媒に関するものである。更に詳しくは、本発明は、特定の触媒の使用によってオレフィン類、特に炭素数3以上のα-オレフィン、の重合に適用した場合、高立体規則性重合体を安定した重合条件で工業生産上有利に製造することを可能とするものである。

従来提案されているチタン、マグネシウムおよびハロゲンを必須成分として含有する固体触媒成分と有機アルミニウムからなるオレフィン重合用触媒は、活性は極めて高いけれども、製品重合体の立体規則性が問題となる場合には重合時に電子供与性化合物を使用する必要があった。

しかしながら、この様な第三成分(外部ドナー)として電子供与性化合物を使用する触媒は、有機

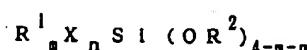
2. 特許請求の範囲

下記成分(A)および成分(B)よりなるオレフィン重合用触媒。

成分(A)

成分(I)：チタン、マグネシウムおよびハロゲンを必須成分として含有する固体成分、

成分(II)：一般式



(ただし、R¹およびR²は炭化水素残基であり、Xはハロゲンであり、mおよびnはそれぞれ0≤m≤3および0≤n≤3であって、しかも0≤m+n≤3である。)で表わされるケイ素化合物、

成分(III)：有機亜鉛化合物、
を接触させて得られる固体触媒成分。

アルミニウム化合物と電子供与性化合物が反応するため重合速度が低下することや、重合速度を高めるべく重合温度を上昇させると前記反応が促進されることから、重合温度を高めて重合量アップ(製造効率アップ)を図ることが制限されることなどから、製品重合体の分子量制御をはじめ製品重合体性能を制御することが困難となる問題がある。

従って、上記問題点を解消する、第三成分(外部ドナー)として電子供与性化合物を使用しないで高立体規則性重合体を高い触媒収率で製造できる触媒系の開発が望まれている。

先行技術

特開昭58-138715号公報には外部ドナーを使用しない、4価チタン、マグネシウム、ハロゲン及び電子供与体を必須成分として含有するチタン複合体(1)と、Si-O-C結合を有する有機ケイ素化合物(2)とを、有機アルミニウム化合物の共存下で反応させるか、または該チタン複合体を有機アルミニウム化合物で処理した後、

(ただし、R¹およびR²は炭化水素残基であり、Xはハロゲンであり、mおよびnはそれぞれ0≤m≤3および0≤n≤3であって、しかも0≤m+n≤3である。)で表わされるケイ素化合物、成分(III)：有機亜鉛化合物、を接触させて得られる固体触媒成分。

成分(B)

有機アルミニウム化合物。

発明の効果

本発明のオレフィン重合用触媒は、重合時に電子供与性化合物(外部ドナー)を使用しないので重合速度の低下が無く、従って重合温度を高くしても問題を生じないなど、公知触媒の問題点を解消するものである。

これらの特色は、工業生産上きわめて有利なことであって、触媒の特色として重要な点である。このような触媒となった理由については、まだ充分に解析できていないが、本発明で使用する成分(II)のケイ素化合物と成分(III)の有機亜鉛化合

該有機ケイ素化合物と反応させて得られた固体成分と、有機アルミニウムから形成される触媒系で重合する方法が開示されている。

しかしながら、この提案では上記問題点の解消は進んでいるが、得られる製品重合体の性能面での限界があり更に触媒の経時劣化、重合時のチタン成分と有機アルミニウム化合物の使用量の量比に制約があるなどまだ改良すべき点が多い。

【発明の概要】

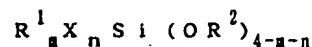
【発明の要旨】

本発明は、上記の点に解決を与えることを目的とするものである。すなわち、本発明によるオレフィン重合用触媒は、下記成分(A)および成分(B)よりなるものである。

【成分(A)】

成分(I)：チタン、マグネシウムおよびハロゲンを必須成分として含有する固体成分、

成分(II)：一般式



物の相互作用によるものと考えられる。

【発明の具体的説明】

【触媒】

本発明の触媒は、特定の成分(A)および成分(B)よりなるものである。ここで「よりなる」ということは、成分が挙示のもの(すなわち、AおよびB)のみであるということを意味するものではなく、合目的的な第三成分の共存を排除しない。

【成分(A)】

本発明の触媒の成分(A)は、前記の成分(I)ないし成分(III)を接触させて得られる固体触媒成分である。ここで、「接触させて得られる」ということは対象が挙示のもの(すなわち(I)～(III))のみであるということを意味するものではなく、合目的的な第四成分の共存を排除しない。

【成分(I)】

成分(I)に用いられるチタン、マグネシウムおよびハロゲンを必須成分として含有する固体成分は公知の固体成分である。例えば、特開昭53-

45688号、同54-3894号、同54-31092号、同54-39483号、同54-94591号、同54-118484号、同54-131589号、同55-75411号、同55-90510号、同55-90511号、同55-127405号、同55-147507号、同55-155003号、同56-18609号、同56-70005号、同56-72001号、同56-86905号、同56-90807号、同56-155206号、同57-3803号、同57-34103号、同57-92007号、同57-121003号、同58-5309号、同58-5310号、同58-5311号、同58-8706号、同58-27732号、同58-32604号、同58-32605号、同58-67703号、同58-117206号、同58-127708号、同58-183708号、同58-183709号、同59-149905号、同59-149906号各公報等に記載のものが使用される。

$Ti(OCH_2CH(C_2H_5)C_4H_9)_4$ 等
 $Ti(OCH_2CH(C_2H_5)C_4H_9)_3Cl$ 、
 $Ti(O-nC_4H_9)_3Cl$ 、
 $Ti(O-C_6H_5)Cl_3$ 、
 $Ti(O-IC_4H_9)_2Cl_2$ 、
 $Ti(OCH_5H_{11})Cl_3$ 、
 $Ti(OCH_6H_{13})Cl_3$ 、
 $Ti(OCH_2H_5)_4$ 、
 $Ti(O-nC_3H_7)_4$ 、
 $Ti(O-nC_4H_9)_4$ 、
 $Ti(O-IC_4H_9)_4$ 、
 $Ti(O-nC_6H_{13})_4$ 、
 $Ti(O-nC_8H_{17})_4$ 、
 $Ti(OCH_2CH(C_2H_5)C_4H_9)_4$ 等
 がある。

また、 TiX'_4 (ここでは X' はハロゲンを示す) に後述する電子供与体を反応させた分子化合物を用いることもできる。具体例としては、

$TiCl_4 \cdot CH_3COCH_2H_5$ 、

本発明において使用されるマグネシウム源となるマグネシウム化合物としては、マグネシウムハライド、ジアルコキシマグネシウム、アルコキシマグネシウムハライド、マグネシウムオキシハライド、ジアルキルマグネシウム、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、マグネシウムのカルボン酸塩等があげられる。

また、チタン源となるチタン化合物は、一般式 $Ti(OR^4)_{4-n}X_n$ (ここで R^4 は炭化水素残基であり、好ましくは炭素数1~10程度のものであり、Xはハロゲンを示し、nは $0 \leq n \leq 4$ の数を示す。) で表わされる化合物があげられる。具体例としては、 $TiCl_4$ 、 $TiBr_4$ 、
 $Ti(OCH_2H_5)Cl_3$ 、
 $Ti(OCH_2H_5)_2Cl_2$ 、
 $Ti(OCH_2H_5)_3Cl$ 、
 $Ti(O-IC_3H_7)Cl_3$ 、
 $Ti(O-nC_4H_9)Cl_3$ 、
 $Ti(O-nC_4H_9)_2Cl_2$ 、

$TiCl_4 \cdot CH_3CO_2C_2H_5$ 、
 $TiCl_4 \cdot C_6H_5NO_2$ 、
 $TiCl_4 \cdot CH_3COCl$ 、
 $TiCl_4 \cdot C_6H_5COCl$ 、
 $TiCl_4 \cdot C_6H_5CO_2C_2H_5$ 、
 $TiCl_4 \cdot ClCOCH_2H_5$ 、
 $TiCl_4 \cdot C_4H_4O$ 等があげられる。

ハロゲン源としては、上述のマグネシウム及びノムはチタンのハロゲン化合物から供給されるのが普通であるが、アルミニウムのハロゲン化物やケイ素のハロゲン化物、リンのハロゲン化物といった公知のハロゲン化剤から供給することもできる。

触媒成分中に含まれるハロゲンはフッ素、塩素、臭素、ヨウ素又はこれらの混合物であってよく、特に塩素が好ましい。

本発明に用いる固体成分は、上記必須成分の他に $SiCl_4$ 、 CH_3SiCl_3 、メチルハイドロジェンポリシロキサン等のケイ素化合物、

Al(O₁C₃H₈)₃、AlCl₃、
AlBr₃、Al(O₂C₂H₅)₃、
Al(OCH₃)₂Cl等のアルミニウム化合物
及びB(OCH₃)₃、B(O₂C₂H₅)₃、
B(O₂C₆H₅)₃等のホウ素化合物等の他成分
の使用も可能であり、これらがケイ素、アルミニ
ウム及びホウ素等の成分として固体成分中に残存
することは差支えない。

更に、この固体成分を製造する場合に、電子供
与体を内部ドナーとして使用して製造することも
できる。

この固体成分の製造に利用できる電子供与体
(内部ドナー)としては、アルコール類、フェノ
ール類、ケトン類、アルデヒド類、カルボン酸類、
有機酸又は無機酸類のエステル類、エーテル類、
酸アミド類、酸無水物類のような含酸素電子供与
体、アンモニア、アミン、ニトリル、イソシアネ
ートの如き含窒素電子供与体などを例示するこ
とができる。

より具体的には、(イ)メタノール、エタノー

メチル、ジクロル酢酸エチル、メタクリル酸メチ
ル、クロトン酸エチル、シクロヘキサンカルボン
酸エチル、安息香酸メチル、安息香酸エチル、安
息香酸プロピル、安息香酸ブチル、安息香酸オク
チル、安息香酸シクロヘキシル、安息香酸フェニ
ル、安息香酸ベンジル、トルイロ酸メチル、トル
イロ酸エチル、トルイロ酸アミル、エチル安息香
酸エチル、アニス酸メチル、アニス酸エチル、エ
トキシ安息香酸エチル、フタル酸ジエチル、フタ
ル酸ジブチル、フタル酸ジヘプチル、 α -ブチロ
ラクトン、 α -バレロラクトン、クマリン、フタ
リド、炭酸エチレンなどの炭素数2ないし20の
有機酸エステル類、(ヘ)ケイ酸エチル、ケイ酸
ブチル、フェニルトリエトキシシランなどのケイ
酸エステルのような無機酸エステル類、(ト)ア
セチルクロリド、ベンゾイルクロリド、トルイロ
酸クロリド、アニス酸クロリド、塩化フタロイル、
イソ塩化フタロイルなどの炭素数2ないし15の
酸ハライド類、(チ)メチルエーテル、エチルエ
ーテル、イソプロピルエーテル、ブチルエーテル、

ル、プロパノール、ベンタノール、ヘキサノール、
オクタノール、ドデカノール、オクタデシルアル
コール、ベンジルアルコール、フェニルエチルアル
コール、クミルアルコール、イソプロピルベン
ジルアルコールなどの炭素数1ないし18のアル
コール類、(ロ)フェノール、クレゾール、キシ
レノール、エチルフェノール、プロピルフェノー
ル、クミルフェノール、ノニルフェノール、ナフ
トールなどのアルキル基を有してよい炭素数6な
いし25のフェノール類、(ハ)アセトン、メチ
ルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、アセ
トフェノン、ベンゾフェノンなどの炭素数3ない
し15のケトン類、(ニ)アセトアルデヒド、ブ
ロピオンアルデヒド、オクチルアルデヒド、ベン
ズアルデヒド、トルアルデヒド、ナフトアルデヒ
ドなどの炭素数2ないし15のアルデヒド類、
(ホ)ギ酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢
酸ビニル、酢酸プロピル、酢酸オクチル、酢酸シ
クロヘキシル、プロピオン酸エチル、醋酸メチル、
吉草酸エチル、ステアリン酸エチル、クロル酢酸

アミルエーテル、テトラヒドロフラン、アニソ
ル、ジフェニルエーテルなどの炭素数2ないし
20のエーテル類、(リ)酢酸アミド、安息香酸
アミド、トルイロ酸アミドなどの酢アミド類、
(ヌ)メチルアミン、エチルアミン、ジエチルア
ミン、トリブチルアミン、ビペリジン、トリベン
ジルアミン、アニリン、ビリジン、ビコリン、テ
トラメチルエレンジアミンなどのアミン類、
(ル)アセトニトリル、ベンゾニトリル、トルニ
トリルなどのニトリル類、などを挙げることが可
能である。これら電子供与体は、2種以上用いるこ
とができる。これらの中で好ましいのは有機酸エス
テルおよび酸ハライドであり、特に好ましいのは
フタル酸エステルおよびフタル酸ハライドである。

上記各成分の使用量は、本発明の効果が認めら
れるかぎり任意のものでありうるが、一般的には、
次の範囲内が好ましい。

チタン化合物の使用量は、使用するマグネシウ
ム化合物の使用量に対してモル比で 1×10^{-4} ~
1000の範囲内がよく、好ましくは0.01~

10の範囲内である。ハロゲン源としてそのための化合物を使用する場合は、その使用量はチタン化合物および/または、マグネシウム化合物がハロゲンを含む、含まないにかかわらず、使用するマグネシウムの使用量に対してモル比で $1 \times 10^{-2} \sim 1000$ の範囲内がよく、好ましくは0.1~100の範囲内である。ケイ素、アルミニウムおよびホウ素化合物の使用量は、上記のマグネシウム化合物の使用量に対してモル比で $1 \times 10^{-8} \sim 100$ の範囲内がよく、好ましくは0.01~1の範囲内である。

電子供与性化合物の使用量は、上記のマグネシウム化合物の使用量に対してモル比で $1 \times 10^{-8} \sim 10$ の範囲内がよく、好ましくは0.01~5の範囲内である。

成分(I)は、上述のチタン源、マグネシウム源およびハロゲン源、更には必要により電子供与体等の他成分を用いて、例えば以下の様な製造法により製造される。

(イ) ハロゲン化マグネシウムと電子供与体と

アルコキシドおよび電子供与体で溶解させて、ハロゲン化剤またはチタンハロゲン化合物で析出させた固体成分に、チタン化合物を接触させる方法。

(ホ) グリニャール試薬等の有機マグネシウム化合物をハロゲン化剤、還元剤等と作用させた後、これに電子供与体とチタン化合物とを接触させる方法。

(ヘ) アルコキシマグネシウム化合物にハロゲン化剤および/またはチタン化合物を電子供与体の存在もしくは不存在下に接触させる方法。

これらのうちでは、メチルハイドロジエンボリシロキサン、1,3,5,7テトラメチルシクロテトラシロキサン、1,3,5,7,9ペンタメチルシクロペンタシロキサンが特に好ましい。

成分(II)

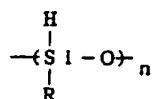
成分(A)を製造するために使用する成分(II)は、一般式 $R^1_m X_n Si(OR^2)_{4-m-n}$ (ただし、 R^1 および R^2 は炭化水素残基であり、Xはハロゲンであり、mおよびnはそれぞれ $0 \leq m \leq 3$ および $0 \leq n \leq 3$ であって、しかも $0 \leq m+n \leq 3$

チタン含有化合物とを接触させる方法。

(ロ) アルミナまたはマグネシアをハロゲン化リン化合物で処理し、それにハロゲン化マグネシウム、電子供与体、チタンハロゲン含有化合物を接触させる方法。

(ハ) ハロゲン化マグネシウムとチタンテトラアルコキシドおよび特定のポリマー-ケイ素化合物を接触させて得られる固体成分に、チタンハロゲン化合物およびまたはケイ素のハロゲン化合物を接触させる方法。

このポリマー-ケイ素化合物としては、下式で示されるものが適当である。

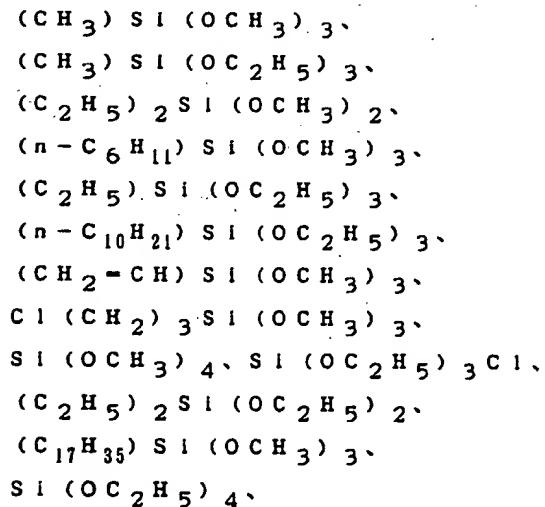


(ここで、Rは炭素数1~10程度の炭化水素残基、nはこのポリマー-ケイ素化合物の粘度が1~100センチストークス程度となるような重合度を示す)

(ニ) マグネシウム化合物をチタニウムテトラ

である)で表わされるケイ素化合物である。 R^1 および R^2 は、それぞれ1~20程度、好ましくは1~10、の炭化水素残基であることが好ましい。Xは、塩素が少なくとも経済性からいって好ましい。

具体例としては、



$(C_6H_5)Si(OCH_3)_3$ 、
 $Si(OCH_3)_2Cl_2$ 、
 $(C_6H_5)_2Si(OCH_3)_2$ 、
 $(C_6H_5)(CH_3)Si(OCH_3)_2$ 、
 $(C_6H_5)Si(OCH_2H_5)_3$ 、
 $(C_6H_5)_2Si(OCH_2H_5)_2$ 、
 $NC(CH_2)_2Si(OCH_2H_5)_3$ 、
 $(C_6H_5)(CH_3)Si(OCH_2H_5)_2$ 、
 $(n-C_3H_7)Si(OCH_2H_5)_3$ 、
 $(CH_3)Si(OCH_3H_7)_3$ 、
 $(C_6H_5)(CH_2)Si(OCH_2H_5)_3$ 、



$Si(OCH_2H_5)_3$ 、



$Si(OCH_3)(OCH_2H_5)_2$ 、

$Si(OCH_3)(OCH_2H_5)_2$ 、
 $CH_3CSi(CH_3)(OCH_3)_2$ 、
 $(CH_3)_3CSi(HC(CH_3)_2)(OCH_3)_2$ 、
 $(CH_3)_3CSi(CH_3)(OCH_2H_5)_2$ 、
 $(C_2H_5)_3CSi(CH_3)(OCH_3)_2$ 、
 $(CH_3)(C_2H_5)CHSi(CH_3)(OCH_3)_2$ 、
 $((CH_3)_2CHCH_2)Si(OCH_3)_2$ 、
 $C_2H_5C(CH_3)_2Si(CH_3)(OCH_3)_2$ 、
 $C_2H_5C(CH_3)_2Si(CH_3)(OCH_2H_5)_2$ 、
 $(CH_3)_3CSi(OCH_3)_3$ 、
 $(CH_3)_3CSi(OCH_2H_5)_3$ 、
 $(C_2H_5)_3C-Si(OCH_2H_5)_3$ 、
 $(CH_3)(C_2H_5)CHSi(OCH_3)_3$

等があげられる。

これらの中で好ましいのは、 R^1 の α 位の炭素が2級又は3級で炭素数3~20の分歧鎖状炭化水素残基、特に R^1 の α 位の炭素が3級であって

炭素数4~10の分歧鎖状炭化水素残基、を有するケイ素化合物である。

成分(III)

成分(A)を製造するために使用する成分(III)は、有機亜鉛化合物である。

有機亜鉛化合物としては、一般式

$R^{3-a}Z_nX_a$ (ただし、 R^3 は炭化水素残基、
 X はハロゲンまたはアルコキシド基、 a は $0 \leq a < 2$ の数を表わす) で表わされるものが適当である。 R^3 としては、炭素数1~10程度のものが好ましい。アルコキシド基のアルキル部分は、炭素数1~6程度のものが好ましい。ハロゲンは、塩素が少なくとも経済性からいって好ましい。

具体例としては、 $(CH_3)_2Zn$ 、
 $(C_2H_5)_2Zn$ 、 $(1-C_4H_9)_2Zn$ 、
 $(n-C_8H_{17})_2Zn$ 、 $(C_2H_5)ZnCl$ 、
 $(n-C_4H_9)ZnCl$ 、
 $(CH_3)Zn(OCH_2H_5)$ 、
 $(C_2H_5)Zn(OCH_3)$ 、等があげられる。

成分(A)の製造

上述の成分(I)~成分(III)の接触条件は、本発明の効果が認められるかぎり任意のものであるが、一般的には、次の条件が好ましい。接触温度は、-50~200°C程度、好ましくは0~100°C、である。接触方法としては、回転ポーラルミル、振動ミル、ジェットミル、媒体搅拌粉碎機などによる機械的な方法、不活性希釈剤の存在下に、搅拌により接触させる方法などがあげられる。このとき使用する不活性希釈剤としては、脂肪族または芳香族の炭化水素およびハロ炭化水素、ポリシロキサン(たとえば、前記したポリマーケイ素化合物)等があげられる。

成分(I)~成分(III)の量比は本発明の効果が認められるかぎり任意のものであるが、一般的には、次の範囲内が好ましい。成分(I)と成分(II)の量比は、成分(I)を構成するチタン成分に対する成分(II)のケイ素の原子比(ケイ素/チタン)で0.01~1000の範囲内がよく、好ましくは0.1~100の範囲内である。成分(III)

の使用量は、成分(I)を構成するチタン成分に対する成分(III)の亜鉛の原子比(亜鉛/チタン)で0.01~100の範囲内がよく、好ましくは0.1~30の範囲内である。

成分(B)

成分(B)は、有機アルミニウム化合物である。

具体例としては、 $R^5_{3-n}AlX_n$ または、

$R^6_{3-m}Al(OR^7)_m$ 。(ここで R^5 及び R^6 は同一または異なるてもよい炭素数1~20程度の炭化水素残基または水素原子、 R^7 は炭化水素残基、Xはハロゲン、nおよびmはそれぞれ0≤n<3、0<m<3の数である。)で表わされるものがある。具体的には、(イ)トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリヘキシルアルミニウム、トリオクチルアルミニウム、トリデシルアルミニウム、などのトリアルキルアルミニウム、(ロ)ジエチルアルミニウムモノクロライド、ジイソブチルアルミニウムモノクロライド、エチルアルミニウムセスキクロライド、エチルアルミニウムジク

成分(B)の使用量は、重量比で成分(B)/成分(A)が0.1~1000、好ましくは1~100の範囲である。

〔触媒の使用/重合〕

本発明の触媒は、通常のスラリー重合に適用されるのはもちろんであるが、実質的に溶媒を用いない液相無溶媒重合、溶液重合、または気相重合法にも適用される。また逆続重合、回分式重合または予備重合を行なう方式にも適用される。スラリー重合の場合の重合溶媒としては、ヘキサン、ヘプタン、ベンタン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン等の飽和脂肪族または芳香族炭化水素の単独あるいは混合物が用いられる。重合温度は室温から200℃程度、好ましくは50~150℃であり、そのときの分子量調節剤として筋助的に水素を用いることができる。

本発明の触媒系で重合するオレフィン類は、一般式 $R-CH=CH_2$ 。(ここでRは水素原子、または炭素数1~10の炭化水素残基であり、分枝基を有してもよい。)で表わされるものである。

ロライド、などのアルキルアルミニウムハライド、(ハ)ジエチルアルミニウムハイドライド、ジイソブチルアルミニウムハイドライド、(ニ)ジエチルアルミニウムエトキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシドなどのアルミニウムアルコキシドなどがあげられる。

これら(イ)~(ハ)の有機アルミニウム化合物に他の有機金属化合物、たとえば

$R^8_{3-a}Al(OR^9)_a$ 。(ここで、 $1 \leq a \leq 3$ 、 R^8 および R^9 は同一または異なるてもよい炭素数1~20程度の炭化水素残基である。)で表わされるアルキルアルミニウムアルコキシドを併用することもできる。たとえば、トリエチルアルミニウムとジエチルアルミニウムエトキシドの併用、ジエチルアルミニウムモノクロライドとジエチルアルミニウムエトキシドとの併用、エチルアルミニウムジクロライドとエチルアルミニウムジエトキシドとの併用、トリエチルアルミニウムとジエチルアルミニウムエトキシドとジエチルアルミニウムクロライドとの併用があげられる。

具体的には、エチレン、プロピレン、ブテン-1、ベンテン-1、ヘキセン-1、4-メチルベンテン-1などのオレフィン類がある。好ましくはエチレンおよびプロピレンである。これらの重合の場合に、エチレンに対して50重量パーセントまで、好ましくは20重量パーセントまで、の上記オレフィンとの共重合を行なうことができ、プロピレンに対して30重量パーセントまでの上記オレフィン、特にエチレン、との共重合を行なうことができる。その他の共重合性モノマー(たとえば酢酸ビニル、ジオレフィン等)との共重合を行なうこともできる。

〔実験例〕

実施例1

〔成分(A)の製造〕

充分に乾燥し、窒素置換した0.4リットルのポールミルに12mmのステンレス鋼製ポールを40個充てんし、これに $MgCl_2$ を20g、フタル酸ジヘプチルを15.5ミリリットル導入して回転ポールミルで48時間粉碎した。粉碎終了

後、ドライボックス内で混合粉砕組成物をミルより取り出した。続いて、充分に窒素置換したフラスコに、粉砕組成物を8.8グラム導入し、さらにn-ヘプタン25ミリリットルとTICl₄ 25ミリリットルを導入して100℃で3時間反応させた。反応終了後、n-ヘプタンで充分に洗浄した。得られた固体成分(成分(I))の一部分をとり出して組成分析したところ、Ti含量は、3.01重量パーセントであった。

次に、充分に窒素置換したフラスコに充分に精製したn-ヘプタンを50ミリリットル導入し、これに上記で得た成分(I)を5グラム、次いで成分(II)として

(CH₃)₃CSi(CH₃)(OCH₃)₂を1.2ミリリットルおよび成分(III)としてZn(C₂H₅)₂を0.4グラム導入して、30℃で2時間接触させた。接触終了後、n-ヘプタンで充分に洗浄し、成分(A)とした。

(プロピレンの重合)

操作および温度制御装置を有する内容積1.5

次いでMgCl₂を0.1モル、Ti(O-nC₄H₉)₄を0.2モル導入し、95℃で2時間反応させた。反応終了後、40℃に温度を下げ、次いでメチルヒドロポリシロキサン(20センチストークスのもの)を12ミリリットル導入し、3時間反応させた。生成した固体成分をn-ヘプタンで洗浄した。ついで充分に窒素置換したフラスコに前記と同様に精製したn-ヘプタンを50ミリリットル導入し、上記で合成した固体成分をMg原子換算で0.03モル導入した。ついで、n-ヘプタン25ミリリットルにSiCl₄ 0.05モルを混合して30℃、30分間でフラスコへ導入し、70℃で3時間反応させた。反応終了後、n-ヘプタンで洗浄した。次いでn-ヘプタン25ミリリットルにフタル酸クロライド0.003モルを混合して、70℃、30分間でフラスコへ導入し、95℃で1時間反応させた。反応終了後、n-ヘプタンで洗浄した。次いでTICl₄ 5ミリリットルを導入して、100℃で6時間反応させた。反応終了後、n-

リットルのステンレス鋼製オートクレーブに、充分に脱水および脱酸素したn-ヘプタンを500ミリリットル、成分(B)としてトリエチルアルミニウム125ミリグラム、および上記で合成した触媒成分(A)を15ミリグラム導入した。次いで、H₂を60ミリリットル導入し、昇温昇圧して、重合圧力=5kg/cm²、重合温度=75℃、重合時間=2時間の条件で重合を行なった。重合終了後、得られたポリマースラリーを沪過により分離し、ポリマーを乾燥した。

その結果、88.7グラムのポリマーが得られた。一方、沪過液から0.58グラムのポリマーが得られた。沸騰ヘプタン抽出試験より、全製品I.I(以下T-I.Iと略す)は、97.2重量パーセントであった。MFR=3.9g/10分、ポリマー密度=0.41g/ccであった。

実施例2

【成分(A)の製造】

充分に窒素置換したフラスコに脱水および脱酸素したn-ヘプタン200ミリリットルを導入し、

ヘプタンで充分に洗浄した。チタン含量は、2.45重量パーセントであった。固体成分(A)を製造するための成分(I)とした。

この成分(I)を用い、成分(II)の(CH₃)₃CSi(CH₃)(OCH₃)₂の使用量を1.6ミリリットルに変更した以外は実施例1と同様の条件で接触を行なった。接触終了後、n-ヘプタンで充分に洗浄し、成分(A)とした。

【プロピレンの重合】

成分(B)のトリエチルアルミニウムの使用量を150ミリグラムとした以外は実施例1のプロピレンの重合と同様の条件でプロピレンの重合を行なった。

その結果、172グラムのポリマーが得られ、MFR=2.8g/10分、T-I.I=98.5重量パーセント、ポリマー密度=0.48g/ccであった。

実施例3~6

実施例2の固体成分(A)の製造において、成

分(II)のケイ素化合物として

$(CH_3)_3CSi(CH_3)(OCH_3)_2$ のかわりに表-1に示す化合物を使用した以外は実施例2と同様に触媒の製造を行ない、プロピレンの重合も実施例2と同様に行なった。その結果を表-1に示す。

実施例7～9

実施例3のプロピレンの重合において、成分(B)の有機アルミニウムのかわりに表-2に示す有機アルミニウム化合物を使用した以外は実施例3と同様に重合を行なった。その結果を表-2に示す。

実施例10

〔成分(A)の製造〕

充分に窒素置換したフラスコに脱水および脱酸素したn-ヘプタン100ミリリットルを導入し、次いでMgCl₂を0.1モル、Ti(O-nC₄H₉)₄を0.2モル導入し、95℃で2時間反応させた。反応終了後、35℃に温度を下げ、1, 3, 5, 7-テトラメチルシ

クロテトラシロキサンを1.5ミリリットル導入して、5時間反応させた。生成した固体成分をn-ヘプタンで洗浄した。ついで、充分に窒素置換したフラスコにn-ヘプタン50ミリリットルを導入し、上記で合成した固体成分をMg原子換算で0.03モル導入した。ついでSiCl₄0.06モルを20℃、30分間で導入して、50℃で3時間反応させた。反応終了後、n-ヘプタンで洗浄して、成分(A)を製造するための固体成分(II)とした。固体成分中のチタン含量は、4.52重量パーセントであった。

次に、充分に窒素置換したフラスコに充分に精製したn-ヘプタンを50ミリリットル導入し、これに上記で得た成分(II)を5グラム、次いで成分(III)としてZn(C₄H₉)₄を1.5グラム導入して、30℃で1時間接触させ、接触終了後、n-ヘプタンで充分に洗浄した。次いで、成分(II)として

$(CH_3)_3CSi(CH_3)(OCH_3)_2$ を4.7ミリリットル導入して、40℃で1時間接

触させた。接触終了後、n-ヘプタンで充分に洗浄して、成分(A)とした。

〔プロピレンの重合〕

実施例2の重合条件において、成分(B)のトリエチルアルミニウムの使用量を63ミリグラムにし、重合温度を70℃にした以外は実施例2と同様にプロピレンの重合を行なった。109グラムのポリマーが得られ、MFR=8.6g/10分、T-I, I=96.2重量パーセント、ポリマー嵩比重=0.46g/ccであった。

実施例11

実施例2の成分(A)の製造において、フタル酸クロライドのかわりに安息香酸エチルを使用した以外は実施例2と同様の条件で成分(A)の製造を行なった。プロピレンの重合も実施例2と同様に行なった。その結果、77.8グラムのポリマーが得られ、MFR=6.3g/10分、T-I, I=93.3重量パーセント、ポリマー嵩比重=0.41g/ccであった。

実施例12

実施例1の成分(A)の製造において、成分(II)として

$(CH_3)_3CSi(CH_3)(OCH_3)_2$ を1.8ミリリットル、成分(III)としてZn(C₂H₅)Clを0.47グラム導入して50℃で1時間接触させた以外は全く同様に製造を行ない、プロピレンの重合も全く同様に行なった。80.4グラムのポリマーが得られ、T-I, I=96.6重量パーセント、MFR=4.3g/10分、ポリマー嵩比重=0.42g/ccであった。

実施例13～16

実施例2の成分(A)の製造において、成分(II)のケイ素化合物として表-3に示す化合物を使用した以外は実施例2と同様に触媒の製造を行ない、プロピレンの重合も実施例2と同様に行なった。その結果を表-3に示す。

比較例1～2

実施例1～2の成分(A)の製造において、成

分(II)として $Zn(C_2H_5)_2$ を使用しなかった以外は、全く同様に成分(A)の製造を行ない、プロピレンの重合も全く同様に行なった。その結果を表-4に示す。

比較例3

実施例2の成分(A)の製造において、成分(II)および成分(III)を使用しないで成分(A)の製造を行ない、プロピレンの重合も全く同様に行なった。118グラムのポリマーが得られ、MFR = 30.6 g/10分、ポリマー密度 = 0.32 g/cc、T-I, I = 68.9重量パーセントであった。

表-2

実施例	有機アルミニウム(成分(B))	ポリマー 一収量 (g)	MFR (g/10分)	ポリマー 密度 (g/cc)	T-I, I (重量%)
7	トリイソブチルアルミニウム	217g	1.24	3.9	0.45
8	トリヘキシルアルミニウム	322g	1.19	4.3	0.46
9	トリエチルアルミニウム ジエチルアルミニウムクロライド	75g 25g	1.46	3.5	0.45

表-3

実施例	ケイ素化合物(成分(II))	ポリマー 一収量 (g)	MFR (g/10分)	ポリマー 密度 (g/cc)	T-I, I (重量%)
13	$(C_6H_5)_2Si(OCH_3)_2$	116	1.27	0.39	91.3
14	$(CH_3)Si(OCH_3)_3$	87	1.68	0.37	81.6
15	$(C_6H_5)Si(OCH_3)_3$	99	3.27	0.40	89.9
16	$(C_6H_5)_2Si(OCH_3)_3$	113	2.53	0.39	88.7

表-1

実施例	ケイ素化合物(成分(II))	ポリマー 一収量 (g)	MFR (g/10分)	ポリマー 密度 (g/cc)	T-I, I (重量%)
3	$(CH_3)_3CSi(OCH_3)_3$	136	3.8	0.46	97.5
4	$(CH_3)_3CSi(OCH_3)_3$	141	4.1	0.46	97.8
5	$(CH_3)_3CSi(CH_3)_2OCH_3$	152	5.3	0.45	96.9
6	$Ph-C(CH_3)_2Si(OCH_3)_3$	127	4.7	0.46	97.1

* Ph = フェニル

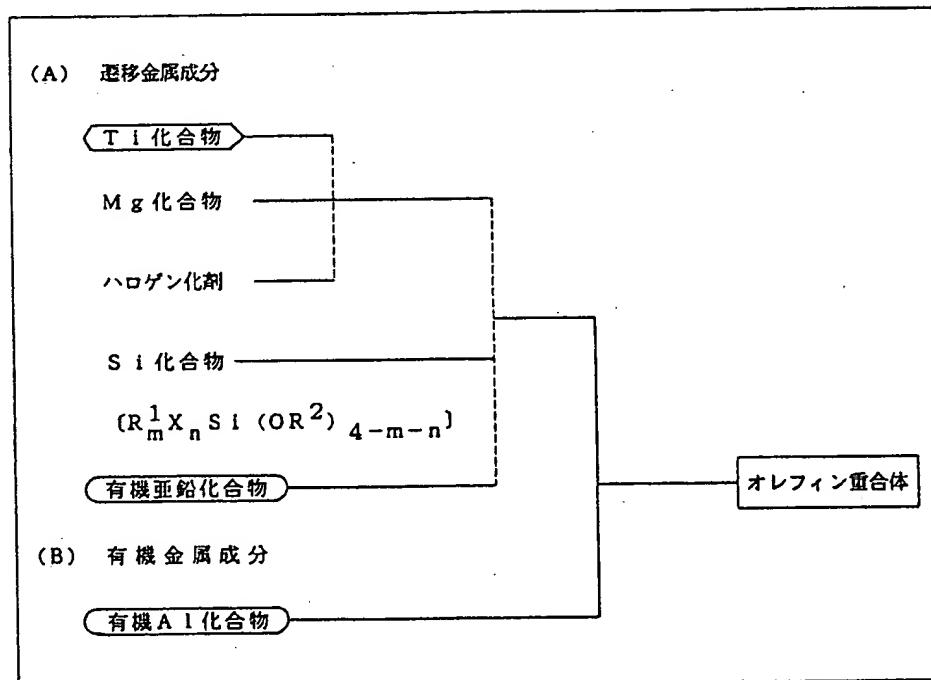
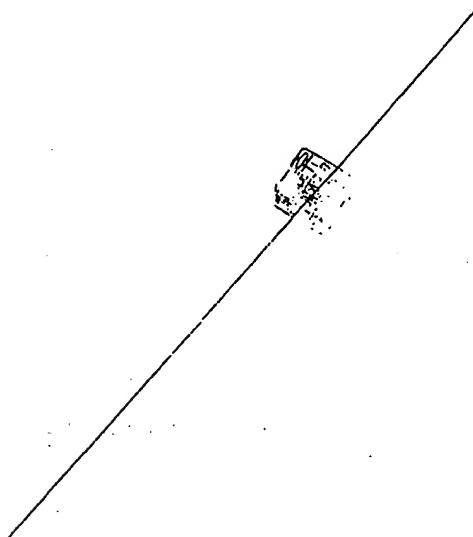
表 - 4

比較例	ポリマー 収量 (g)	MFR (g/10分)	ポリマー 高密度 (g/cc)	T-I.I (重量%)
1	76.6	11.6	0.39	94.8
2	131	7.0	0.45	96.9

4. 図面の簡単な説明

第1図は、チーゲラー触媒に関する本発明の技術内容の理解を助けるためのものである。

出願人代理人 佐藤一雄



第 1 図

特許補正書

昭和62年12月7日

特許庁長官 小川邦夫殿

1 事件の表示

昭和62年 特許願 第82425号

2 発明の名称

オレフィン重合用触媒

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人

(605) 三菱油化株式会社

特許

6212

出願第

4 代理人

東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
電話東京(211)2321大代表

6428 弁理士 佐藤一雄

5 補正命令の日付

昭和 45 年 12 月 1 日

←発送日 昭和 12 月 1 日 →

6 補正により 1 発明の数

7 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄。

8 補正の内容

明細書を下記の通り補正する。

(1) 第16頁下から第2行と最下行との間に下記の文を加入する。

「具体的には、メチルハイドロジエンポリシロキサン、エチルハイドロジエンポリシロキサン、フェニルハイドロジエンポリシロキサン、シクロヘキシルハイドロジエンポリシロキサン、1,3,5,7-テトラメチルシクロテトラシロキサン、1,3,5,7,9-ペンタメチルシクロペンタシロキサンなどを例示できる。」

(2) 第17頁11~14行

「これらのうちでは、~好ましい。」を削除。